



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100628001
2010 年 9 月 7 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

TI-DFAB サイト製造 TLV2371/TLV271 製品 ウェーハサイズ追加変更のご案内

(初版 PCN20100628001 2010 年 7 月 1 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての最終版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	TI-DFABサイト製造 TLV2371/TLV271製品 ウェーハサイズ追加変更 現行 : 150mm径ウェーハ 変更後: 150mm径ウェーハ, 200mm径ウェーハ			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	10 月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容: 弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TI-DFAB(Dallas, 米国) サイト製造 TLV2371/TLV271製品について、現行 LBC3Sプロセス 150mmウェーハ前処理にて製造いたしておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、LBC3Sプロセス 200mmウェーハ前処理での製造を追加し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

ウェーハサイズ

現行

150mm径ウェーハ

変更後

150mm径ウェーハ

200mm径ウェーハ

理由: 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
MP1TLV2371-W	TLV2371IDBVTG4	TLV271CD	TLV271CDR	TLV271IDBVTG4
SN1003028DBVR	TLV2371IDG4	TLV271CDBVR	TLV271CDRG4	TLV271IDG4
TLV2371ID	TLV2371IDR	TLV271CDBVRG4	TLV271ID	TLV271IP
TLV2371IDBVR	TLV2371IDRG4	TLV271CDBVT	TLV271IDBVR	TLV271IPE4
TLV2371IDBVRG4	TLV2371IP	TLV271CDBVTG4	TLV271IDBVRG4	
TLV2371IDBVT	TLV2371IPE4	TLV271CDG4	TLV271IDBVT	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 9 月 1 日		
信頼性試験 — 試料構成詳細						
Qual Device:	TLV271ID	Die Size (mils):		38.35 X 29.45		
Wafer Fab Site:	DFAB (DL-LIN)	Wafer Fab Process:		LBC3S		
Wafer Size:	200 mm	Metallization:		TiW/AlSiCu.5		
Die Protective Coating:	10KACN	-		-		
信頼性試験結果						
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails				
		Lot#1	Lot#2	Lot#3		
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved		
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved		

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2002年2月22日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN104605PN	Die Size (mm):	3.302 X 6.1976	
Wafer Fab Site:	DFAB (DL-LIN)	Wafer Fab Process:	LBC3S	
Wafer Size:	200 mm	Metallization:	TiW/AlCu.5	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C, 1000 Hours	116/0	116/0	116/0
**Biased Hast	130C/85%RH, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
ESD-CDM	500 Volts	3/0	3/0	3/0
ESD-HBM	2500, 3000 Volts	3/0	3/0	3/0
ESD-MM	200 Volts	3/0	3/0	3/0
Bond Strength	-	76/0	76/0	76/0
Die Shear	-	5/0	5/0	5/0
Electrical Characterization	-	50/0	50/0	50/0
Manufacturability (Wafer Fab)	-	Approved	-	-
Manufacturability (Assembly Site)	-	Approved	-	-
Notes: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/220C				